

⑨ 日本国特許庁 (JP) ⑩ 実用新案出願公開  
 ⑪ 公開実用新案公報 (U) 昭55-22140

⑫ Int. Cl. 3  
 H 01 L 21/205 識別記号 庁内整理番号 ⑬ 公開 昭和55年(1980)2月13日  
 C 30 B 25/12  
 H 01 L 21/223  
 21/31 7739-5F  
 6703-4G  
 6684-5F  
 7377-5F  
 ⑭ 審査請求 未請求  
 (全 3 頁)

⑮ 半導体基体の加熱支持台  
 ⑯ 実 願 昭53-104411  
 ⑰ 出 願 昭53(1978)7月28日  
 ⑱ 考 案 者 伊藤博之  
 伊丹市瑞原4丁目1番地三菱電機株式会社北伊丹製作所内  
 ⑲ 代理人 弁理士 葛野信一 外1名  
 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

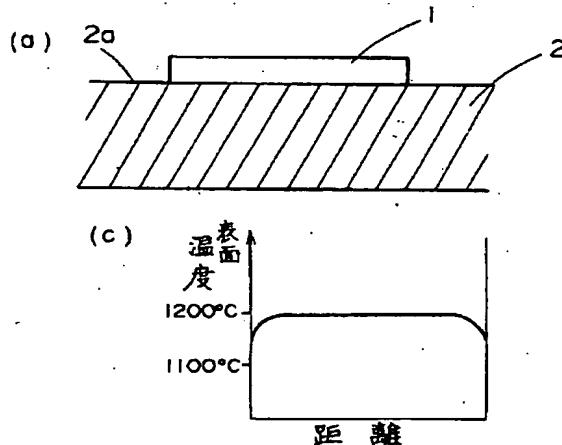
⑲ 実用新案登録請求の範囲  
 (1) 半導体基体の支持面を凹形に形成して、この半導体基体を下面周縁、周辺部の一部もしくは全部で支持面上に載置させて、少なくとも下面中央部が支持面に直接触れないようにしたことを特徴とする半導体基体の加熱支持台。  
 (2) 半導体基体の支持面を、この半導体基体の外径を含む範囲内で次第に傾斜する傾斜面としたことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項記載の半導体基体の加熱支持台。  
 (3) 半導体基体の支持面を、この半導体基体の外径を含む範囲内で次第に傾斜する傾斜面と、同外径よりも小径の平面とによる凹形に形成したことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項記載の半導体基体の加熱支持台。  
 (4) 半導体基体の支持面を、この半導体基体の外

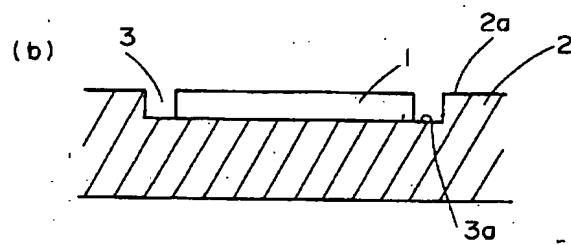
径を含む範囲内で中央に凹面をもつ段部支持面としたことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項記載の半導体基体の加熱支持台。

図面の簡単な説明  
 第1図 a, b, c ないし第3図は従来の加熱支持台の各例による断面と、その半導体基体の表面温度分布を示す説明図、第4図 a, b ないし第6図 a, b はこの考案に係わる加熱支持台の各別の実施例による構成断面と、その半導体基体の表面温度分布を示す説明図である。

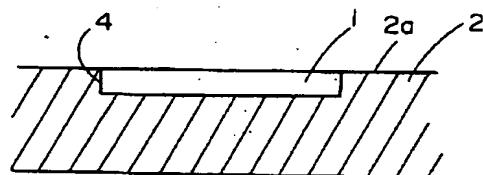
1 1 ……半導体基体、1 1 a ……下面周縁部、  
 1 1 b ……下面中央部、1 1 c ……下面周辺部、  
 1 2 ……加熱支持台、1 2 a ……傾斜面、  
 1 2 b ……平面、1 2 c ……段部支持面、1 2 d  
 ……凹面、1 2 e ……傾斜面、1 3 ……空間。

第1図

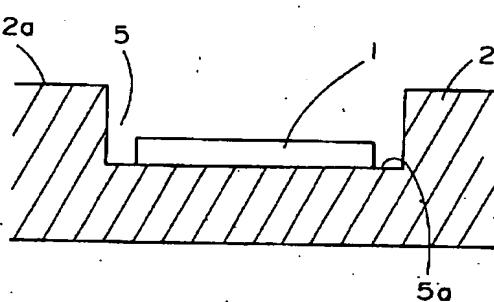




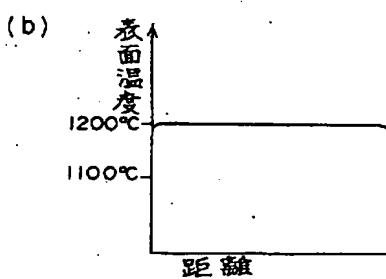
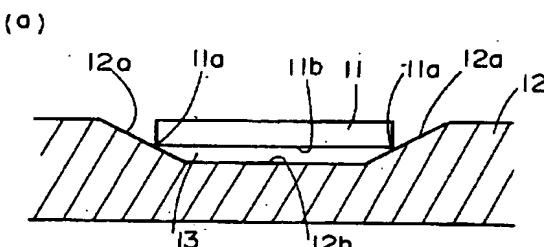
第2図



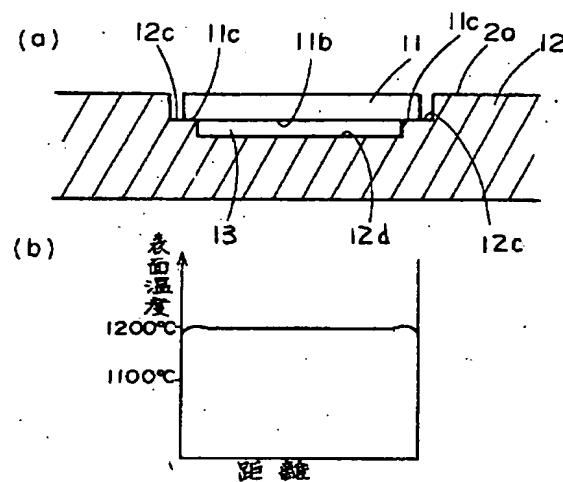
第3図



第4図



第5図



第6図

